

# 고분자 멤브레인을 이용한 반도체 나노와이어 구조체 제조

고분자 멤브레인과 귀금속 촉매를 이용한 반도체 나노와이어 구조체 제조기술

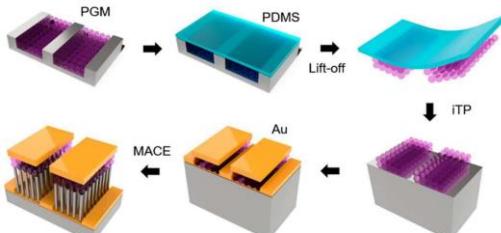
적용 분야  
제품

기술 개요

기술 경쟁력

지식  
재산권  
현황

문의처



- 반도체 나노와이어 분야는 전자적, 화학적, 광학적, 열적으로 우수한 특성을 가지기 때문에 FET, 화학센서, 바이오센서, 환경센서 등 다양한 산업에 응용될 것으로 기대됨
- 실리콘 나노와이어는 차세대 배터리, CMOS 트랜지스터, 열전 소자, 태양 전지, 발광 소재, 바이오센서 등 다양한 분야 핵심 소재임
- 실리콘 나노와이어의 특성은 크기에 따라 달라지며, 나노 구조물을 작게 만들수록 더 높은 성능을 발휘할 수 있음

## 기준기술

## 기술 차별성

## 대상기술

- 반도체 나노와이어 제조방법은 상향식(Bottom-up) 방법과 하향식(Top-down) 방법이 있음
- 상향식 방법은 비교적 쉽게 다양으로 제조할 수 있으며, 하향식 방법은 나노와이어의 위치와 형태를 비교적 쉽게 제어할 수 있고 재현성이 높음

### 기술적 한계

- 상향식 방법의 경우 나노와이어의 위치와 형태를 제어하는 데 많은 제약이 있으며, 재현성이 낮음
- 하향식 방법은 다양한 나노와이어의 제조가 어려우며, 수나노미터 크기 영역에서 매우 작은 직경의 나노와이어를 만들어 가이드 패턴의 해상도를 낮추는 것이 어려움

- 기능성 금속-고분자 복합체는 마이크로전자공학, 광전자공학, 플라즈모닉스 및 바이오센서를 포함한 광범위한 응용 분야 존재
- 고분자 필름 내부의 물리적 증착된 금속 원자의 확산도 광범위하게 연구개발 중이며, 다양한 확산 메커니즘 제안

### 기술적 우위

- 멤브레인을 통한 금속촉매의 확산경로를 엔지니어링하여 서브나노미터에서 수십나노미터에 이르는 반도체 나노구조체 형성
- 고분자 멤브레인과 귀금속 촉매를 이용하여 탑다운 방식으로 제어하면서 반도체 나노와이어 구조체를 제조하는 방법 개발

발명의 명칭	출원(등록)번호	출원(등록)일자
고분자 멤브레인을 이용한 반도체 나노와이어 구조체의 제조방법 및 이에 의해 제조되는 반도체 나노와이어	출원: 10-2024-0033486	출원: 2024.03.08.